PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-045071

(43) Date of publication of application: 16.02.1999

(51)Int.CI.

GO9G 3/30 GO9G

GO9G 3/20 // H05B 33/08

(21)Application number: 10-144218

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

26.05.1998

(72)Inventor: NISHIGAKI EITARO

KAWASHIMA SHINGO

(30)Priority

Priority number: 09139984

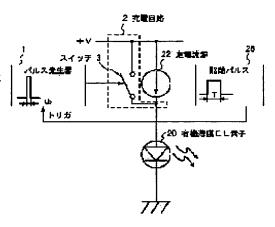
Priority date : 29.05.1997

Priority country: JP

(54) DRIVING METHOD OF ORGANIC THIN FILM EL ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent brightness from decreasing even if a capacitive element is driven and to extend a life of an organic thin film EL element by charging a junction capacitor of the organic thin film EL element upto a specified potential by an pulse output synchronizing with an output of a current driving means. SOLUTION: A charging circuit 2 has a switching element 3. A pulse generator 1 is triggered by a drive pulse 26, outputs a pulse of a period to very short compared with the drive pulse period T, and brings the switching element 3 into conduction. When the switching element 3 is brought into conduction, a power source voltage +V is directly impressed on the organic thin film EL element 20. Then, a current limited by a constant current source 22 is made to flow through the organic thin film EL element 20 in a state released from the current limit, and quickly charges a junction capacitor portion of the organic thin film EL element 20. On-period tb of the switching element 3 is set beforehand at a period long



enough to charge the junction capacitor portion of organic thin film EL element 20.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.05.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3102411

[Date of registration]

25.08.2000

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-45071

(43)公開日 平成11年(1999)2月16日

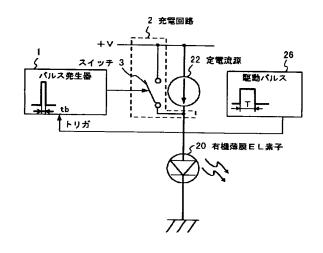
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
G 0 9 G 3/30		G 0 9 G 3/30 J
3/20	6 1 1	3/20 6 1 1 J
	6 2 3	6 2 3 C
// НО5В 33/08		H 0 5 B 33/08
		審査請求 有 請求項の数5 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	特願平10-144218	(71) 出願人 000004237
		日本電気株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月26日	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 西垣 栄太郎
(31)優先権主張番号	特願平9-139984	東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
(32)優先日	平 9 (1997) 5 月29日	式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 川島 進吾
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)
		A TOTAL STATE OF THE STATE OF T
		·

(54) 【発明の名称】 有機薄膜EL素子の駆動回路

(57)【要約】

【課題】容量性の有機薄膜EL素子を定電流駆動した場合の、素子の輝度を向上させる。

【解決手段】パルス発生器1で駆動パルス26と同期したパルスを生成する。充電回路2は、パルス発生器1の出力によって決められた期間の間だけ、EL素子20を充電する。充電時間は、スイッチング素子3のオン抵抗とEL素子20の接合容量とで決まる。



30

が盛んである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機薄膜発光層を挟持する少なくとも一 方が透明な信号電極及び走査電極とを含む複数の有機薄 膜EL素子をマトリクス駆動するための有機薄膜EL素 子の駆動回路において、

入力信号に応じて前記信号電極に定電流駆動信号を供給 する電流駆動手段と、

前記電流駆動手段の出力に同期したパルスを出力するパ ルス発生器と、

前記パルス発生器の出力により前記有機薄膜EL素子の 10 接合容量を所定の電位に充電する充電回路とを有すると とを特徴とする有機薄膜EL素子の駆動回路。

【請求項2】 前記充電回路は、スイッチング素子を有 し、前記パルス発生器の出力により前記スイッチング素 子を作動させ、前記スイッチング素子のオン抵抗と前記 有機薄膜EL素子の接合容量とによって定まる時定数で 前記有機薄膜EL素子を所定の電位に充電する構成であ ることを特徴とする、請求項1に記載の有機薄膜EL素 子の駆動回路。

【請求項3】 前記充電回路による充電時間は、前記電 20 流駆動手段のバルス出力時間より短いことを特徴とす る、請求項1に記載の有機薄膜EL素子の駆動回路。

【請求項4】 有機物からなる発光層とその発光層を挟 持する少なくとも一方が透明な信号電極及び走査電極と を含む複数の有機薄膜EL素子をマトリクス駆動するた めの有機薄膜EL素子の駆動回路において、

入力信号に応じて前記信号電極に定電流駆動信号を供給 する電流駆動手段と、

前記電流駆動手段の出力に同期したバルスを出力するバ ルス発生器と、

前記パルス発生器の出力により前記有機薄膜EL素子の 接合容量を所定の電位に充電する充電回路とを有し、前 記任意の1の走査電極を駆動する駆動バルスにおいて次 の走査電極の駆動パルスとの間に前記有機薄膜EL素子 に充電された電荷を放電する期間を設けたことを特徴と する有機薄膜EL素子の駆動回路。

【請求項5】 前記電荷を放電する期間は、前記任意の 1の走査電極を駆動する駆動バルスを所定の期間短縮し たものと次の走査電極の駆動パルスとの間の期間である の駆動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機薄膜のエレク トロルミネッセンス(EL)現象を利用した有機薄膜E L素子の駆動回路に関し、特に、EL素子をマトリクス 駆動して文字や図形を表示する際に用いられる有機薄膜 ELの駆動回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ある種の有機薄膜を陽極、陰極の各電極 50 電極(この場合は、陽極31)を形成したときは、支持

で挟み込み通電すると、それぞれの電極から注入された 正孔と電子とが有機薄膜内で再結合し、その時のエネル ギーにより発光現象が生じることが知られている。この 現象は有機薄膜ELと呼ばれ、数V~十数V程度の直流 電圧で駆動可能で、他のディスプレイデバイスに比べて も発光効率が高く、また、本体が薄くて軽い等の利点も あることから、各種発光デバイスへの応用へ向けて研究

【0003】このEL現象は発光しうる有機薄膜(以 下、有機発光薄膜層と記す)が単層であっても生じる が、より低い印加電圧で高輝度を得るには、各電極から 有機発光薄膜層へのキャリアの注入効率を向上させる必 要がある。そのため、電極と有機発光薄膜層との間のエ ネルギー障壁高さを減じ、有機発光薄膜層へのキャリア 移動を容易にすることを目的として、電極と有機発光薄 膜層との間にキャリア注入層もしくはキャリア輸送層を 付加した積層構造が提案されている。例えば、特開昭5 7-51781号公報に開示された陽極/有機正孔輸送 層/有機発光薄膜層/陰極の構造や、特開平6-314 594号公報記載の陽極/複数の有機正孔注入輸送層/ 有機発光薄膜層/複数の有機電子注入輸送層/陰極の構 造などのような積層構造が挙げられる。尚、積層順はこ れらの例の逆であっても構わない。図5に、支持基板上 に形成された陽極/有機正孔輸送層/有機発光薄膜層/ 陰極からなる、一般的な積層構造有機薄膜EL素子の断 面と、素子に対する電圧印加の方法を示す。

【0004】図5を参照して、図示された有機薄膜EL 素子を構成する材料としては、まず電極は、有機発光薄 膜層からの光を取り出さなければならない都合上、少な くとも陰・陽どちらかの電極は透光性を有していること が必要である。多くは、陽極31に、インジウム・すず 酸化物(ITO)の膜や金の薄膜などが用いられてい る。一方、陰極34には、電子の注入障壁高さを低くす る目的から、仕事関数の小さい材料が選ばれ、マグネシ ウム、アルミニウム、インジウムなどの金属膜或いはそ れら金属の合金膜などが用いられている。有機正孔輸送 層32には、芳香族3級アミン、ポリフィリン誘導体な どが用いられ、有機発光薄膜層33には、8-ヒドロキ シキノリン金属錯体、ブタジエン誘導体、ベンズオキサ ことを特徴とする、請求項4に記載の有機薄膜EL素子 40 ドール誘導体などが用いられている。また、図示する有 機薄膜EL素子には用いられてはいないが、有機電子輸 送層を備える構造の場合は、これにナフタルイミド誘導 体、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド誘導体、キナク リドン誘導体などが用いられている。電極と有機薄膜層 は、ガラスや樹脂フィルムなどの支持基板上に真空蒸着 やスパッタなどのドライ成膜法により形成したり、上記 した材料を樹脂や溶媒に分散させ又は溶解させた溶液か ら、スピンコートやディッピングなどのウェット成膜法 により順次積層して形成される。尚、第1層に透光性の

基板30も透光性のものとすることが必要である。 【0005】ところで、上述のように構成されたEL素子に電圧を印加すると、図6のような、ダイオードに似た電圧-電流特性を示す。従って、素子を駆動するには、電流駆動を行うのが一般的である。

【0006】上述したような構造、電気的特性の有機薄 膜ELを応用したデバイスとして、従来、上に例示した 有機薄膜EL素子構造を単位画素とし、その単位画素を 1枚の支持基板上に平面的に2次元配置し、マトリクス 駆動をする平面発光型有機薄膜ELディスプレイが提案 10 されている。その一例(従来例1)が、特開平7-36 410号公報に開示されている。 すなわち、上記公報に よる従来例1の駆動回路の原理的回路図を示す図7を参 照すると、表示パネル10は、Xドライバ12及びYド ライバ14によって駆動されるようになっており、Xド ライバ12からの信号電極16-0, 16-1, 16-2, ……と Y ドライバ 1 4 からの走査電極 1 8 - 0, 1 8-1, ……とにより、表示パネル10のマトリクスが 構成される。そして、マトリクスのそれぞれの交点に発 光素子20が接続されている。Xドライバ12は、定電 20 流源22-0, 22-1, 22-2, ……を含み、それ ら定電流源22-0, 22-1, 22-2, ……は、制 御コンピュータ24から駆動パルス信号26を受けると ともに、電源電圧(=+V)を受け、信号電極16-0, 16-1, 16-2, ……に発光素子点灯用の定電 流を出力する。また、Yドライバ14は、スイッチ素子 28-0, 28-1, ……を含み、それらスイッチ素子 は、制御コンピュータ24からの制御信号29によりオ ン、オフ作動し、走査電極18-0, 18-1, ……を グランドに接続したりグランドから遮断したりして、マ 30 トリクス駆動を行っている。

【0007】図11は、前述の図7について、さらに具 体的な回路構成を示したものである。図11において、 映像信号は、A/Dコンバータ36を介してメモリとし てのシフトレジスタ38に供給され、該シフトレジスタ 38は、複数のフリップフロップ回路(以下FFとい う) 44~44を含む。シフトレジスタ38内のFFか らの信号は、Xドライバ40内でFF46~46を介し てPWM変調器48~48に供給される。PWM変調器 48~48からの信号(輝度データに対応したパルス幅 40 を示すアナログ信号)は、信号電極A0, A1, A2, A 3, …に供給され、一方、Yドライバ34内のFF50 ~50からの信号は、走査電極K0, K1, K2, K3, … に供給され、とれらの信号電極AO, A1, A2, A3, … 及び走査電極K0, K1, K2, K3, …により、表示バネ ル30のマトリクスが構成される。表示パネル30にお いて、信号電極A0, A1, A2, A3, …と走査電極K 0, K1, K2, K3, …との交点部分では信号電極A0, A1, A2, A3, …及び走査電極K0, K1, K2, K3, …に発光素子52~52が接続されている。

【0008】コントローラとしてのタイミングジェネレータ42は、水平同期信号及び垂直同期信号を受取り、信号SCLK、LCLK、FPUL、及びFCLKを出力する。信号SCLKは、A/Dコンバータ36及びシフトレジスタ38内のFF44~44に供給され、信号LCLKはXドライバ40内のFF46~46に供給され、信号FPUL及びFCLKは、Yドライバ34内のFF50~50に供給される。

【0009】図12(A)のXドライバのタイミングチャートを図を用いて説明すると、映像信号をA/Dコンバータ36でA/D変換してサンプリングする毎に、A/D変換されたデータDATAは、信号SCLKにより、シフトレジスタ38内のFF44~44に順次シフトされる。そして、1水平同期期間のデータDATAが全てFF44~44に送られると、信号LCLKにより、FF44~44内のデータはXドライバ32内のFF46~46を介してPWM変調器48~48に供給される。PWM変調器48~48は送られたデータをPWM変調し、データに対応する長さのバルスを信号電極Aの、A1、A2、A3、…に出力する。

【0010】(B)のYドライバのタイミングチャートを説明すると、信号FPULは、垂直同期期間に1回 "High"レベルになり、信号FCLKにより、信号FPULのバルスが走査電極(ライン)K0、K1、K2、K3、…に順次転送されていく。そして、走査ラインK0(n=0,1,2,3,…)が"High"レベルのとき、そのラインK0が点灯することになる。なお、信号FCLKは1水平同期期間に1回バルスを出力し、信号FPULは1垂直同期期間に1回バルスを出力する。

【0011】とのように、従来例1の特開平7-364 10号公報には、定電流駆動でマトリクス状の発光素子 を駆動する方法が開示されている。

【0012】次に、特開平3-157690号公報は、 薄膜ELディスプレイの駆動に従来用いられている第2 番目の方法の例(従来例2)を開示している。 すなわ ち、互いに交差する方向に配列した複数の走査側電極 と、複数のデータ側電極との間にEL素子を介在させた 表示装置ELにパルス幅変調方式を適用して階調表示を 行うときの駆動方法であって、選択走査電極上の各絵素 に印加する電圧として、パルス後部の波高値に比べてパ ルス前部の波高値が高い波形のバルス電圧を用いて駆動 する方法である。従来例2の駆動方法におけるパルス波 形を示す図8を参照して、図8(a)は最高輝度Bmax の発光状態のときのパルス波形を、図8(b)は中間輝 度BXの発光状態のときのパルス波形を、図8(c)は 非発光状態 (輝度 B o) のときのパルス波形を、それぞ れ示している。ことでは、パルス前部からパルス後部へ と波高値が減少する波形をなすランプ電圧が用いられて いる。この従来例2の駆動方法は、主に、第1フィール 50 ド、第2フィールドを有し交流電圧で駆動するELディ

スプレイに用いられるもので、EL素子をしきい値付近 の実効電圧(Vw2)で動作させた場合に輝度むらのない 階調表示を行うために、発光の最初の段階でEL素子に 高い電圧(Vw1)を印加して、画素を構成するEL素子 の発光層に蓄積されている電荷を消失させ、蓄積電荷に 影響されない発光を行わせることを目的するものであっ て、EL素子を交流電圧で駆動する方法に係わる発明で

[0013]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の技術に 10 おける第1の問題は、従来例1の平面発光型有機薄膜E Lディスプレイでは、入力信号に応じて信号電極に定電 流駆動信号を供給しているが、このとき方形波状のパル ス信号で駆動すると、パルスの立上がりが遅れてしま い、輝度が上がらないという問題である。有機薄膜EL 素子は接合容量を有するので、一定の電流で駆動する と、まず容量に充電した後に発光動作に移行するので、 発光開始まで電圧が上がるのに時間がかかるからであ

【0014】説明を簡潔にして理解を容易にするため に、図7に示される回路図から1画素分だけ抜き出して 表すと、従来例1は有機薄膜EL素子20を、図9に示 すような構成で駆動していることになる。ここで、有機 EL素子20を方形波状のパルス信号26で駆動する と、EL素子20には、図10に示す電圧波形中でOA PQで示されるパルス電圧が印加される。図10におい て、縦軸中の電圧VFはEL素子の順方向電圧であり、 電圧VaはEL素子が発光を開始する電圧である。横軸 中の時間taは、バルスで駆動し始めてから発光を開始 するまでの時間である。また、時間Tは、EL素子に駆 30 動バルスを印加している時間であって、例えば、ダイナ ミック点灯で64分の1デューティ、繰り返し周波数1 50Hzで駆動するとすれば、Tは約104μsとな

【0015】図10を参照すると、本来は、Tの期間駆 動パルスを印加しているのに、実際にEL素子が発光し ているのは(T‐ta)の時間であって、当然ながら発 光の輝度も時間taの分だけ暗くなることが分る。具体 的に一例を挙げれば、EL素子の素子サイズが0.52 なり、時間taは、約30μsとなる。この時間ta= 30 µsは、時間T=104 µsに比べて無視できない 値である。ピーク輝度は13800cd/m²(直流 時) なので、平均輝度は本来216cd/m2あるとこ ろ、126 c d/m² と大きく低下することになる。マ トリクスの規模がより大きくなりデューティが小さくな ると、時間 taは変らずに時間丁が短くなる。そして、 ta>Tでは発光不能になってしまう。

【0016】次に、従来の技術における第2の問題は、 従来例1の平面発光型有機薄膜ELディスプレイでは、

EL素子の寿命を短くしてしまうということである。 有機EL素子の輝度は電流によって決まる。このことか ら、上述のように駆動パルスの立上がりが遅いままで必 要な輝度を得ようとすると、必要以上に電流値を上げな ければならず、より多くの電流をEL素子に流さなけれ ぱならない。その結果、EL素子の温度上昇を招き、素 子の劣化を早めてしまうのである。

【0017】従って本発明の目的は、容量性の素子を駆 動しても、輝度の低下を防ぐことができる有機薄膜EL 素子の駆動回路を提供することである。

【0018】本発明はまた、有機薄膜EL素子の寿命を 延ばすことを目的とする。

[0019]

20

【課題を解決するための手段】本発明の有機薄膜EL素 子の駆動回路は、有機物からなる発光層とその発光層を 挟持する少なくとも一方が透明な信号電極及び走査電極 とを含む複数の有機薄膜EL素子をマトリクス駆動する ための有機薄膜EL素子の駆動回路において、入力信号 に応じて前記信号電極に定電流駆動信号を供給する電流 駆動手段と、前記電流駆動手段の出力に同期したパルス を出力するバルス発生器と、前記バルス発生器の出力に より、前記有機薄膜EL素子の接合容量を所定の電付に 充電する充電回路とを有することを特徴とする。

【0020】本発明の有機薄膜EL素子の駆動回路は、 EL素子を駆動する定電流駆動信号を供給する電流駆動 手段に、パルス発生器の出力によりEL素子の駆動立上 がり時にEL素子を所定の電位に充電する充電回路を設 けた。このため、EL素子の駆動立上がりを早くするこ とができ、容量性の素子においても輝度が低下するのを 防止できる。

[0021]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て、図面を参照して説明する。始めに、本発明の第1の 実施の形態の基本動作について説明する。図1は、本発 明の動作原理を示すブロック図であって、マトリクス状 の素子を駆動する回路の内、1画素分を抜き出したもの である。図1を参照して、充電回路2は、スイッチング 素子3を有している。パルス発生器1は、駆動パルス2 6によってトリガがかけられ、駆動パルス期間下に比べ mm×0.52mmならば、接合容量は約670pFと 40 て非常に短い期間 t b のパルスを出力し、スイッチング 素子3を導通させる。スイッチング素子3が導通する と、電源電圧+Vが直接EL素子に印加される。する と、定電流源22によって制限されていた電流が、制限 が無くなった状態でEL素子20に流れ、EL素子20 の接合容量分を急速に充電する。スイッチング素子のオ ン期間 t b は予め、E L素子20の接合容量分を充電す るだけの期間に設定しておく。このとき、駆動パルス2 6によって定電流源22も駆動されるので、EL素子2 0に流れ込む電流は、駆動パルスとスイッチング素子に 50 よる電流とが加算された状態になる。

【0022】本実施の形態においてEL素子20に印加 されるバルス波形を、図2に示す。図2を参照して、従 来例1の定電流による駆動方法では、図10中の〇AP Qで示される波形のパルスで駆動されていたが、本実施 の形態では、充電回路2の働きにより、図2の0BPQ の状態で駆動される。パルス〇BPQの立上がり期間で は、スイッチング素子3のオン抵抗とEL素子20の接 合容量とによって決定される時定数で定まり、バルス幅 Tに比べて十分短い時間であるので、この期間でによる 輝度の減少は、実用上無視できる程度のレベルである。 具体的な一例を挙げれば、ダイナミック点灯で64分の 1デューティ、繰り返し周波数150Hzで駆動すると すれば、駆動バルス印加期間Tは約104μsとなる。 パルスOBPQの立ち上がり期間では、EL素子20に 印加される電圧とスイッチング素子3のオン抵抗とによ って異なるが、例えばτ=2 μs程度となる値(素子に かかる電圧と期間 t b) を選べば、平均輝度は126 c

【0023】なお、EL素子にかかる電圧は、電源電圧 20 以外から任意の電圧を与えることも可能である。

d/m² (従来例1における輝度)から211cd/m

'に改善され、実用上ほとんど問題はなくなる。

【0024】次に、本発明の第2の実施の形態について 説明する。図3は、本発明の第2の実施の形態の構成を 示すブロック図である。定電流源22の電流を変調する 電流変調回路4を設けた点が、第1の実施の形態とは異 なっている。電流変調回路4は、例えば図4に示すよう に、図1で用いられている定電流源22と、それに付帯 する充電回路としてのスイッチング素子(トランジス タ)5とで構成されている。

【0025】図4を参照して、電源電圧+Vはカレント 30 あり、XSTBは図4の期間Tの駆動パルスである。 ミラー構成の定電流源22に供給される。この定電流源 22内のトランジスタ90、91には、基準電流 I ref が供給されている。定電流源22からの定電流は、トラ ンジスタ92を経てEL素子20に供給される。トラン ジスタ92は、ベースに加えられる駆動パルス26に応 じて、定電流をEL素子20に流したり遮断したりす る。ととで、EL素子20に流れる定電流値は、抵抗9 3及び抵抗94によって決定される。電流値を決定する 抵抗のうち一方の抵抗93には、その両端を短絡可能 イッチングトランジスタ5は、バルス発生器1で作られ たパルスtbによって導通するように、インパータ6を 通して接続されている。本実施の形態では、スイッチン グトランジスタ5とインバータ6とで充電回路を構成し ている。

【0026】いま、パルス発生器で幅 t b のパルスが作 られたとすると、期間tbだけスイッチングトランジス タ5がオン状態となり、抵抗93を短絡する。すると、 電流値を設定する抵抗93、94のうち抵抗93が短絡 するので、合計の抵抗値が小さくなり、 抵抗94で定

められた増加した電流が、EL素子20に向って流れる

ことになる。電流変調回路4は、このように、EL素子 に流れる電流値を期間 t b だけ大きくする働きする。 【0027】との第2の実施の形態においてEL素子に かかるパルスの状態は、第1の実施の形態におけると同 じく、図2の0BPQで示される状態になる。 そして、 **このパルスの立上がり期間τは、スイッチングトランジ** スタ5のオン抵抗とEL素子の接合容量とによって定ま る時定数で決まり、第1の実施の形態におけると同様 10 に、駆動パルス幅Tに比べて十分短い時間に設定でき る。すなわち、抵抗93と抵抗94の比、及びパルス発 生器の出力 t b の期間を $\tau = 2 \mu$ s 程度に調整すれば、 全体のパルス幅T=104μs に対して十分短い時間で あるので、輝度の減少は、ほとんど問題のないレベルと なる。さらに、本願発明を適用したマトリクス構造の有 機薄膜EL素子の駆動回路の構成を示すと、図13のよ うになる。

【0028】図13において、Xドライバ60はELパ ネル62のカラム線(信号電極)C1,C2,C3・・ ·を駆動し、Yドライバ61はELパネル62のロウ線 (走査電極) R1, R2, R3・・・を駆動する。 Xド ライバ60には、データジェネレータ64で作られたデ ータ信号(XDATA)とタイミングジェネレータ65 で作られたXドライバ用タイミング信号(XCLK、X STB、PGEN) が入力される。また、Yドライバ6 1にはタイミングジェネレータ65で作られたYドライ バ用タイミング信号(YCLK、YSTB等)が入力さ れる。図4の1素子の説明図に当てはめると、データ信 号(XDATA)は、図4の1refを決定する信号で

【0029】Xドライバ60の内部には定電流駆動部6 6があり、その内部は、本願発明による回路(第1、第 2の実施例である図4等)が1出力に1回路づつ接続し ている。また、タイミングジェネレータ65で作られた PGENが図3や図4のバルス発生器1の出力に相当 し、電流変調回路に期間 t b のパルスを入力する。タイ ミングジェネレータ65からXSTBとPGENを出力 する時点では、両パルスを同時に立ち上げれば、両パル スの立ち上がりに差はないが、XSTBが有機ELの駆 に、スイッチングトランジスタ5が接続されている。ス 40 動パルスとしてXドライバ60の定電流駆動部66から 出力される時点では、EL素子の接合容量により駆動バ ルス(XSTB)の立ち上がりが遅れるので、もともと 同時に立ち上がっているパルス幅tbのPGENを利用 して、本願発明の電流変調回路を動作させれば、ほとん ど立ち上がりが遅れることなく、Eし素子を駆動できる ことになる。具体的には、前述したように2μ s 程度の 遅れで立ち上げることができる。

> 【0030】Xドライバ60及びYドライバ61の出力 信号のタイミングチャートを図14から図17に示す。 50 図14から図17は、XドライバとYドライバの駆動波

形を示す。これらの図では、Yドライバの波形がLレベ ルで、Xドライバの波形がHレベルのときにEL素子が 点灯することになる。

【0031】図14は、従来のXドライバとYドライバ の駆動波形を示す。Xドライバ60の内部は、図9のよ うな従来の回路で構成されている。Yドライバ61から は、R1, R2, R3···のように1水平期間Tの駆 動バルスが互いに重なることなく順次出力される。この 図14の従来例の場合、Xドライバの立ち上がりは、E L素子の接合容量によって遅れてしまう。

【0032】図15は、本願発明を適用した場合のXド ライバとYドライバの駆動波形である。本案の充電回路 を追加することによって、Xドライバの駆動波形の立ち 上がりは改善されている。これは、図2で説明したとお りである。

【0033】図16は、本案を適用した場合に、図16 (e)のようにXドライバの出力でHレベルが連続する ような画面があったような場合、EL素子の電荷が放電 されず、本案の充電回路で充電すると必要以上に充電さ がってしまい、輝度としては明るくなって、Lレベルか ら立ち上がった場合と輝度差が出てしまうという現象が 起こることがある。

【0034】とのような現象を改善したのが、第3の実 施例として図17に示すように、1水平期間のLレベル になっている期間をTからtcだけ短くしたものであ る。このようにYドライバの期間が短くなると、EL素 子が点灯する時間が短くなり、Xドライバの波形も

(d)、(e)、(f)のように1パルスづつ透き間が 空いて、本案の充電回路で充電した場合に必要以上に充 30 電することがなくなり、Hレベルが連続した場合とそう でない場合との画面輝度が違うという現象を改善するこ とができる。

【0035】図17のようにYドライバの駆動パルスを 期間(T-tc)にするためには、タイミングジェネレ ータ65のYSTBのパルス幅をTから(T-tc)に 変更するだけでよい。このときtcの時間は、有機EL 素子に充電された電荷が充分放電されるまでの時間であ る。但し、あまりtcが長いと輝度が下がってしまうの で輝度の低下を考慮しながら t c を決定する。具体的に 40 は、図2のパルスの立ち下がりPQの時間で、デューテ ィ1/64、駆動周期150Hz、パルスの振幅10V のとき、7μs程度であったので、tcの値としては1 0μs程度でよく、Τの値が104μsであるとする と、輝度の低下は10%以下に収まる。

【0036】また、図17のようにYドライバの駆動バ ルスを期間 (T- t c) にするためのタイミングジェネ レータ65内の具体的回路としては、例えば図18 (a)、(b)の回路を用いれば、期間Tから期間(T -tc)を作成することができる。図18(a)は、単 50 【図9】従来例1の一画素分のブロック図である。

10

安定マルチバイブレータを用いて期間Tのパルスを期間 (T-tc)へ短縮するものである。また、図18

(b)は、期間Tのパルスと期間 t c のパルスの論理和 をとって、期間(T-tc)のパルスを作成するもので ある。このような回路を用いれば、容易にタイミングジ ェネレータ65のYSTBのパルス幅をTから(T-t c) に変更することができる。

[0037]

【発明の効果】以上の説明したように、本発明は、有機 薄膜EL素子の駆動回路に対し、EL素子を駆動する定 10 電流駆動信号を供給する電流駆動手段に、バルス発生器 の出力によりEL素子の駆動立上がり時にEL素子を所 定の電位に充電する充電回路を設けている。

【0038】また、画面の内容によって充電回路の効果 が大きすぎ、連続してEL素子が点灯している場合と連 続していない場合に輝度が異なってしまう時には、 走査 側パルスのパルス幅を1走査期間より短くする。

【0039】とれにより本発明によれば、入力信号に応 じて信号電極に方形波状のパルス信号で定電流駆動する れて、図16(e)のようにVcc付近までレベルがあ 20 場合に、EL素子が容量性であっても、輝度の低下を抑 制できる。どく短い時間でEL素子の接合容量を充電す ることができ、バルスの立上がりを遅らせることなく駆 動することができるからである。

> 【0040】また、本発明によれば、EL素子の寿命を 延ばすことができる。駆動パルスの立上がりが遅いまま 必要な輝度を得ようとして多くの電流を流す必要がな く、EL素子の無駄な温度上昇が抑えられるからであ る。

【0041】さらに、走査パルスの期間が短くなると、 EL素子が点灯する時間が短くなり、駆動パルスに少し づつ透き間が空いて、本発明の充電回路で充電した場合 に必要以上に充電することがなくなるからである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の一画素分のブロッ ク図である。

【図2】第1の実施の形態におけるバルス波形を示す図 である。

【図3】本発明の第2の実施の形態の一画素分のブロッ ク図である。

【図4】第2の実施の形態の一画素分のトランジスタレ ベルの回路図である。

【図5】有機薄膜EL素子の一例の構造及び電圧印加方 法を示す図である。

【図6】有機薄膜EL素子の電流一電圧特性の一例を示 す図である。

【図7】従来例1の表示装置の駆動回路の回路図であ る。

【図8】従来例2のEL素子のパルス駆動波形を示す図 である。

12

11

【図10】従来例1におけるバルス波形を示す図である。

【図11】従来例1の表示装置の回路構成を示す図であ ろ

【図12】従来例1の表示装置のタイミングチャートを 示す図である。

【図13】本発明の実施の形態の駆動回路の全体構成を 示す図である。

【図14】従来の駆動回路のタイミングチャートを示す 図である。

【図15】本発明の第2の実施の形態の駆動回路のタイミングチャートを示す図である。

【図16】本発明の駆動回路のタイミングチャートを示す図である。

【図17】本発明の第3の実施の形態の駆動回路のタイミングチャートを示す図である。

【図18】本発明の第3の実施の形態の駆動回路の一部 を説明する図である。

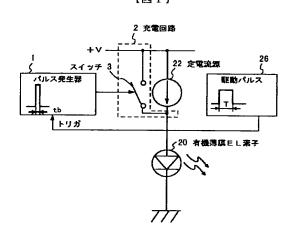
【符号の説明】

.

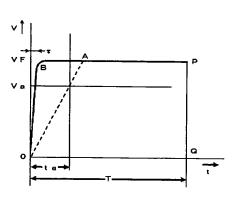
- 1 パルス発生器
- 2 充電回路
- 3 スイッチング素子
- 4 電流変調回路
- 5 スイッチング素子

- *6 インバータ
 - 20 有機薄膜EL素子
- 22 定電流源
- 26 駆動パルス
- 30 表示パネル
- 32 Xドライバ
- 34 Yドライバ
- 36 A/Dコンバータ
- 38 シフトレジスタ(メモリ)
- 10 42 コントローラ
 - 44 フリップフロップ
 - 46 フリップフロップ
 - 48 PWM変調器
 - 50 フリップフロップ
 - 52 発光素子
 - 60 Xドライバ
 - 61 Yドライバ
 - 62 ELパネル
 - 64 データジェネレータ
- 20 65 タイミングジェネレータ
 - 66 定電流駆動部
 - 90.91 トランジスタ
 - 92 トランジスタ
- k 93,94,95 抵抗

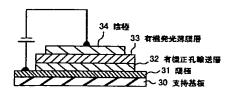
【図1】

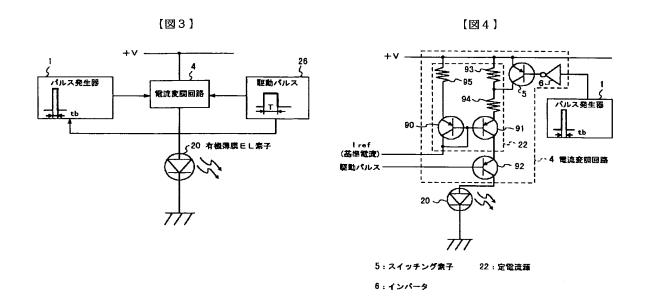


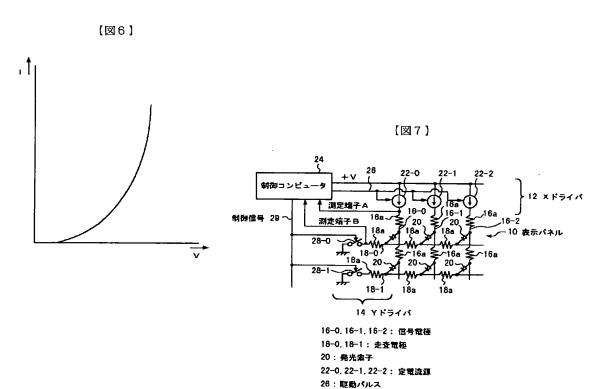
【図2】

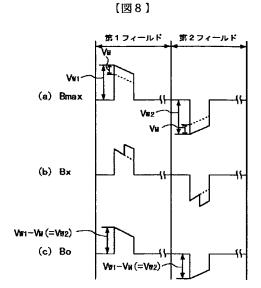


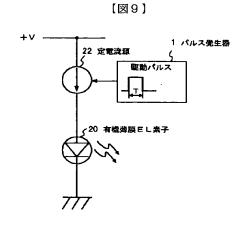
【図5】



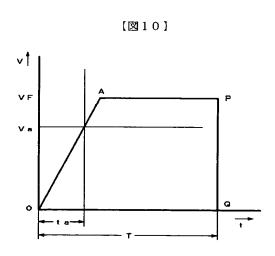


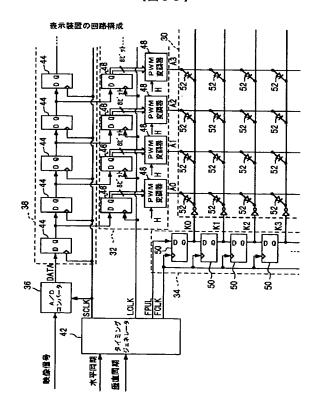






【図11】

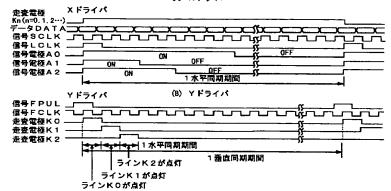




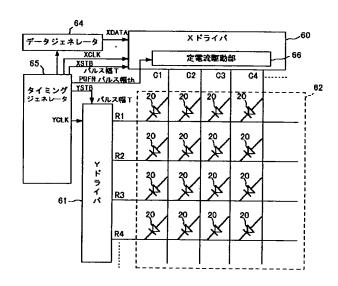
【図12】

表示装置のタイミングチャート

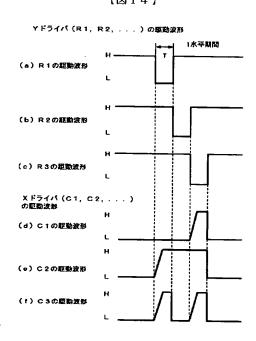
(A) X ドライバ



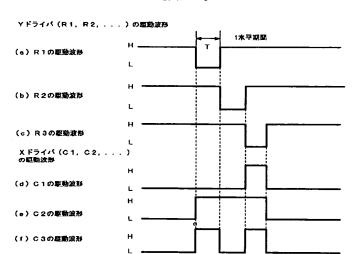
【図13】



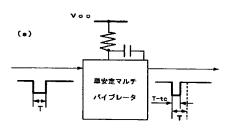
【図14】

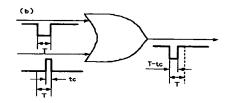


【図15】

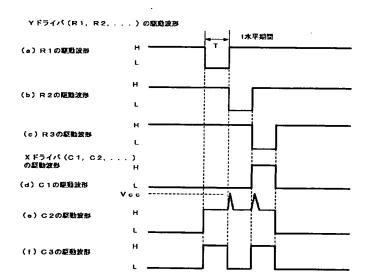


【図18】





【図16】



【図17】

Yドライバ(R1, R2, ...) の駆動波形

